Super Fast Recovery Diode

SF10L60U

600V 10A

特 長

- 高耐圧FRD
- 低ノイズ
- trr=25ns
- フルモールド
- 絶縁耐圧 2kV保証

Feature

- High Voltage Super FRD
- Low Noise
- trr=25ns
- Full Molded
- Dielectric Strength 2kV

用 途

- スイッチング電源
- アクティブフィルタ

Main Use

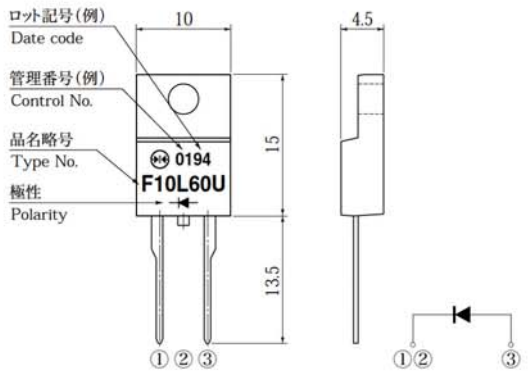
- Switching Regulator
- PFC(Power Factor Correction)

■外観図 OUTLINE

Package：FTO-220

Unit：mm

Weight 1.9g(Typ)



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 Tc＝25℃）

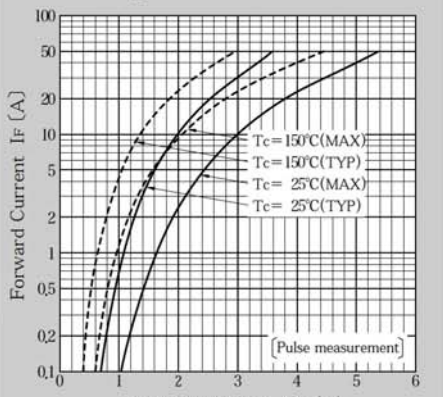
項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions / 品 名 Type No.	SF10L60U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		−55～150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波，抵抗負荷，Tc＝85℃，フィン付き 50Hz sine wave, Resistance load, Tc=85℃, With heatsink	10	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	120	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間，AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2.0	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値：0.3N・m) (Recommended torque : 0.3N・m)	0.5	N・m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合 Tc＝25℃）

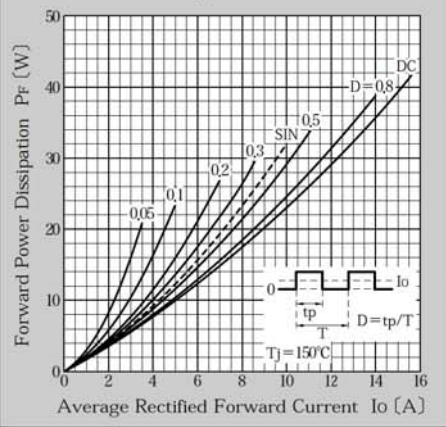
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 10A$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 3.00	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 25	μA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f＝1MHz, $V_R = 10V$	TYP 55	pF
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5A$, $I_R = 1.0A$	MAX 25	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.0	℃/W

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

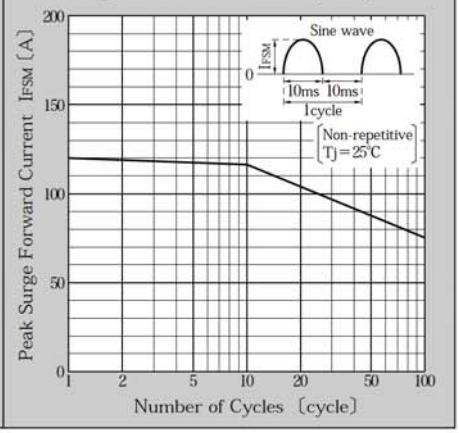
順方向特性
Forward Voltage



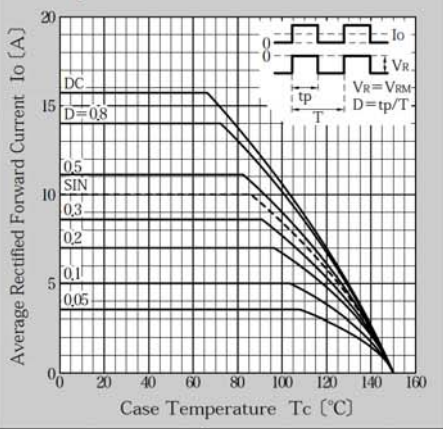
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



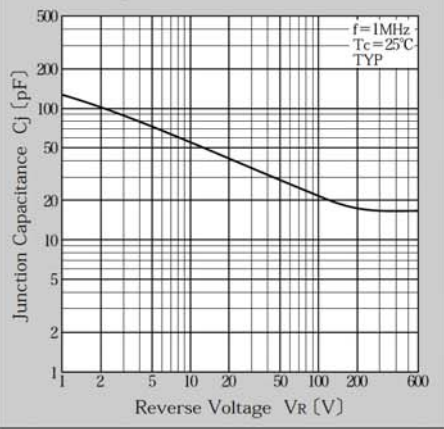
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



ディレーティングカーブ Tc-Io
Derating Curve Tc-Io



接合容量
Junction Capacitance



＊Sine waveは50Hzで測定しています。
＊50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
＊Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9